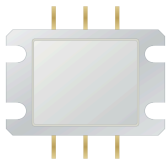
2300–3900 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 50 dBm (典型值)

LCT-2300-3900-PS50T · 2300–3900 MHz · GaN 内匹配功率晶体管.



RF 电气表参数: PSAT 50 dBm (典型值); 功率增益 12 dB (典型值); PAE 50 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS.

GF136GD

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

RF端口需外加隔直电容。

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

封装外形尺寸: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	2300	-	3900	MHz
饱和输出功率	-	49	50	-	dBm
功率增益	-	11	12	-	dB
功率附加效率	-	45	50	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	1.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
夹断电压 [1]	-	-4	-	-2	V
栅极反向电流 [2]	-	-	-	0.01	A

[1] VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA

[2] VDS = 0 V; VGS = -10 V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	50	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	175	°C
最高沟道温度	-	-	-	200	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	24 × 15.9 × 4.4	mm
引脚总跨距	17.4	mm

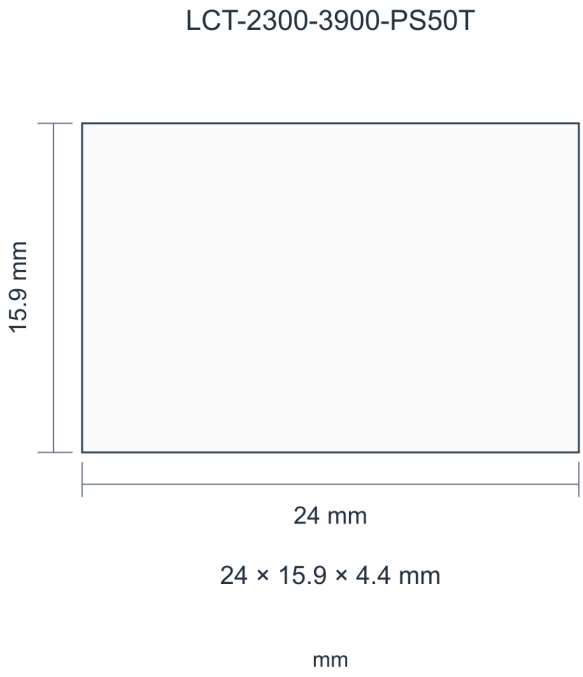
当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

GF136GD 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF RF端口需外加隔直电容。 Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

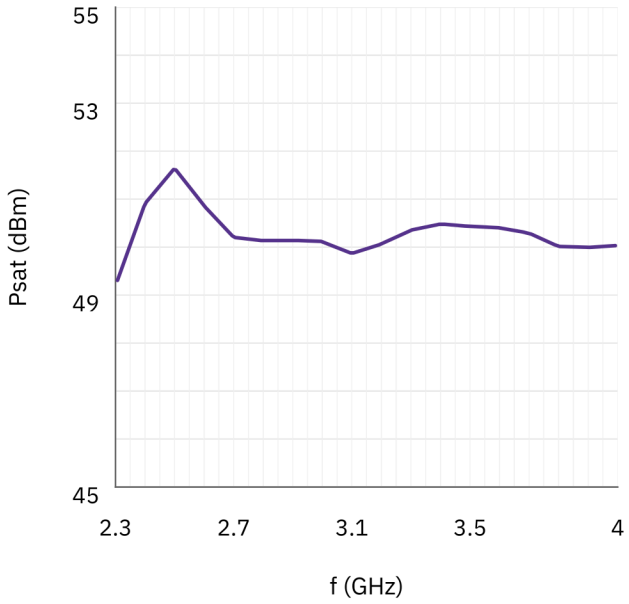


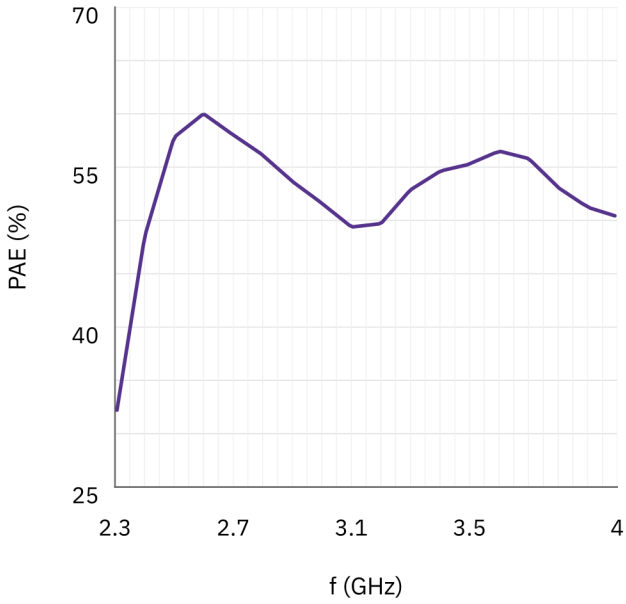
性能曲线

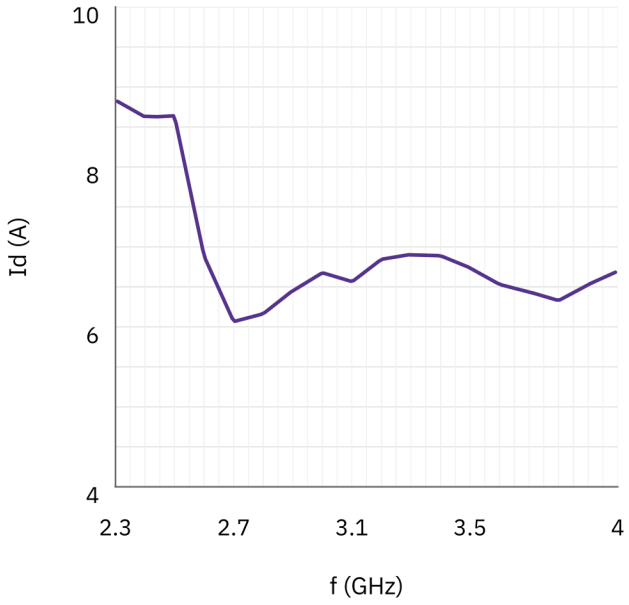
各性能曲线对应图中标注的工作条件。

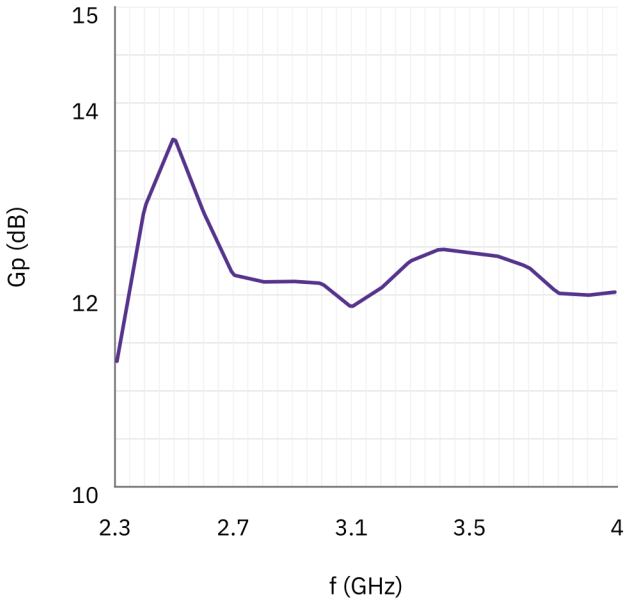
连续波（CW） — 饱和输出功率、功率附加效率、动态漏极电流、功率增益。

图注：Vd=+28V; Vg=-3.3V; Pin=38dBm。 图中读数为近似值。









文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。